

Mandag 19.02.07

Gauss' lov for \mathbf{D} :

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{A} = Q_f$$

der Q_f er netto *fri* ladning innenfor den lukkede flaten S . (Netto total ladning innenfor S er $Q_{\text{in}} = Q_f - Q_i$, med $-Q_i =$ netto *bundet* ladning, knyttet til polariseringen \mathbf{P} , innenfor S .)

Elektrisk susceptibilitet og permittivitet; lineær respons.
[FGT 25.5; YF 24.4; TM 24.5, 24.6; AF 25.9; LHL 20.5; DJG 4.4]

Lineær respons: \mathbf{P} proporsjonal med \mathbf{E} , dvs vi kan skrive

$$\mathbf{P} = \chi_e \varepsilon_0 \mathbf{E}$$

der vi har innført $\chi_e =$ elektrisk susceptibilitet.

NB: En slik lineær sammenheng mellom \mathbf{P} og \mathbf{E} gjelder *ikke alltid*, men i dette kurset skal vi hele tiden anta at det gjelder. Merk også at \mathbf{E} er det *totale* elektriske feltet, *ikke bare* det ytre feltet.

Dermed:

$$\begin{aligned} \mathbf{D} &= \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} \\ &= (1 + \chi_e) \varepsilon_0 \mathbf{E} \\ &= \varepsilon_r \varepsilon_0 \mathbf{E} \\ &= \varepsilon \mathbf{E} \end{aligned}$$

Her har vi innført størrelsene

$\varepsilon_r = 1 + \chi_e =$ relativ permittivitet (“dielektrisitetskonstanten”)

$\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0 =$ mediets permittivitet

Enheter:

$[\chi_e] = [\varepsilon_r] = 1$ (dimensjonsløs)

$[\varepsilon] = [\varepsilon_0] = \text{C}^2/\text{Nm}^2$

Punktladning q i dielektrikum med permittivitet ε :

Elektrisk felt: $\mathbf{E}(r) = (q/4\pi\varepsilon r^2)\hat{r}$

Elektrisk potensial: $V(r) = q/4\pi\varepsilon r$

Dvs: Som for punktladning i vakuum, men med $\varepsilon_0 \rightarrow \varepsilon > \varepsilon_0$; mediet polariseres og *skjjermer* punktladningen slik at E og V reduseres med en faktor $1/\varepsilon_r$.

Tirsdag 20.02.07

Kondensator og kapasitans.

[FGT 25.1, 25.5; YF 24.1, 24.4; TM 24.2, 24.5; AF 25.10; LHL 20.1; DJG 2.5.4]

Kondensator = to adskilte elektriske ledere med ladning $\pm Q$ (Eventuelt: En elektrisk leder med ladning Q , den andre tenkt flyttet uendelig langt bort.)

Coulombs lov \Rightarrow elektrisk felt i området omkring lederne er proporsjonalt med Q

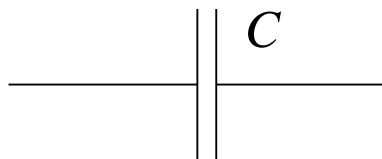
Dermed følger også at *potensialforskjellen* ΔV mellom de to lederne er proporsjonal med Q :

$$C = \frac{Q}{\Delta V}$$

C = kondensatorens *kapasitans*

Enhet for kapasitans: $[C] = [Q/\Delta V] = \text{C/V} \equiv \text{F}$ (farad)

Symbol i elektriske kretser:



C er en *geometrisk faktor*, avhengig av ledernes utforming og innbyrdes avstand, og dessuten det mellomliggende mediet.

Kapasitans er, pr definisjon, en *positiv størrelse*.

Utregning av C for et gitt system vil gå ut på å bestemme potensialforskjellen mellom de to lederne, $\Delta V = V_+ - V_-$, for en gitt ladning $\pm Q$.

Parallellplatekondensator, luftfylt (vakuum), med plateareal A , plateavstand d :

$$C = \varepsilon_0 \frac{A}{d}$$

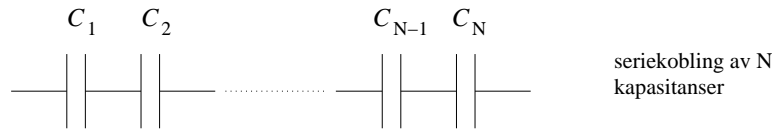
Parallellplatekondensator, fylt med dielektrikum med relativ permittivitet ε_r , plateareal A , plateavstand d :

$$C = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{A}{d}$$

Dersom området mellom kondensatorens to ledere, som i utgangspunktet er fylt med luft (\simeq vakuum), helt eller delvis fylles med et dielektrikum, vil kondensatorens kapasitans alltid bli større enn den var med bare luft. (Det samme gjelder også hvis området med luft/vakuum erstattes med metall.)

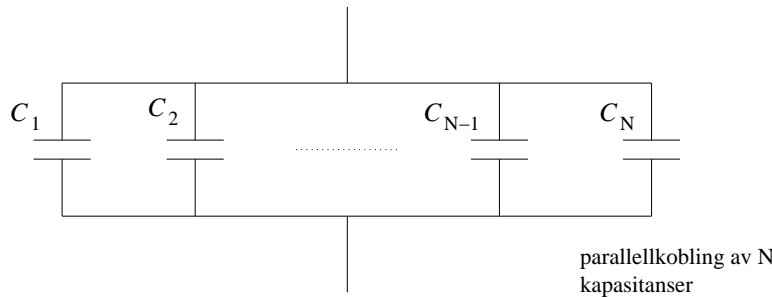
Kobling av flere kapasitanser

[FGT 25.4; YF 24.2; TM 24.4; AF Ex. 25.8, LHL 20.2]:



Seriekobling av N kapasitanser C_i , $i = 1, \dots, N$:

$$\frac{1}{C} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{C_i}$$



Parallellkobling av N kapasitanser C_i , $i = 1, \dots, N$:

$$C = \sum_{i=1}^N C_i$$

I disse uttrykkene representerer C den ekvivalente kapasitansen dersom vi erstatter alle de serie- eller parallellkoblede kapasitansene med en enkelt kapasitans.

Energi assosiert med elektrisk felt

[FGT 25.3; YF 24.3; TM 24.3; AF 25.11; LHL 20.4; DJG 2.4.3]

Potensiell energitetthet, dvs potensiell energi pr volumenhet, er med elektrisk felt E lik

$$u = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2$$

Vi hadde også at potensiell energi kunne "assosieres" med den elektriske ladningen: Dersom et "system" har elektrisk potensial (f.eks. relativt til potensialet uendelig langt borte, som vi som regel kan sette lik null) $v(q)$ når det har ladning q , må vi utføre et arbeid $dW = v(q) dq$ for å øke ladningen fra q til $q + dq$. Følgelig blir totalt arbeid, og dermed også total "lagret" potensiell energi i systemet, lik

$$W = U = \int_0^Q v(q) dq$$

for å lade opp systemet fra null ladning til endelig ladning Q .

Alternativt kan vi altså regne ut lagret potensiell energi ved å integrere opp energitettheten u over hele volumet V :

$$U = \int_V u \, dV = \int_V \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 \, dV$$

(Merk at her står V for *volum* og ikke potensial. Dessuten: Ikke la deg forvirre av notasjonen brukt ovenfor: Jeg brukte $v(q)$ for å angi potensialforskjellen mellom de to kondensatorplatene med ladning q og $-q$, dvs på et vilkårlig tidspunkt underveis i oppladingen. Grunnen var at jeg ønsket å reservere V for potensialforskjellen mellom platene når de var ferdig oppladet, dvs med ladning Q og $-Q$. Jeg forsøker å minimere ”sammenblanding” av symboler, men V bruker jeg altså for potensial *og* volum.)